Название статьи (размер шрифта 17, прямой, жирный): С прописной буквы только первое слово и собственные имена

**И О Фамилия1,3, И О Фамилия2, И О Фамилия1,2**

1 Название подразделения, Название организации, №, ул. Название, Город, почтовый индекс, Страна

2 Название подразделения, Название организации, №, ул. Название, Город, почтовый индекс, Страна

3 Электронный адрес автора-корреспондента: adress@email.ru

**Abstract.** Текст аннотации обязателен. Используйте 10-ый шрифт, одиночный межстрочный интервал, 25 мм отступ от левого поля листа. В аннотации необходимо отразить: предмет и предпосылки исследования; материалы, средства и методы (с указанием на их оригинальность); основные достигнутые результаты и их значение. Рекомендуемый объём – 150 слов.

1. Введение (подзаголовок I уровня – 11 шрифт, жирный)

Основной текст – 11 шрифт. Межстрочный интервал - одинарный. Отступы до и после абзаца – отсутствуют. Красная строка - 0,5 см (для всех абзацев после подзаголовка, кроме первого). Выравнивание текста – по ширине.

В качестве разделителя дробной и целой частей используется «точка» (в том числе на рисунках и в таблицах).

Для оформления таблиц используйте 11 шрифт. Сетка в таблицах не строится полностью (линиями отделяются только заголовки колонок; вертикальных линий быть не должно). Название таблицы помещается в верхнюю строку (без границы сверху). Таблицы размещаются «в тексте» (без обтекания). Таблицы выравнивается по центру.

|  |
| --- |
| **Table 1.** Название таблицы |
| Поля | **Используйте лист А4** |
| Верхнее | 4.0 cm |
| Нижнее | 2.7 cm |
| Левое | 2.5 cm |
| Правое | 2.5 cm |
| Колонтитулы | 0 cm |

Не используйте сноски и интерактивные ссылки.

1. Название раздела 1

Рекомендуемая структура разделов в статье: Введение, Постановка проблемы, Материалы и методы, Обсуждение результатов, Заключение.

* 1. Подзаголовок II уровня (размер шрифта – 11, курсив)

Возможно использование заголовков 2-ого уровня. Название подзаголовка размещается в отдельной строке.

Подзаголовок III уровня (*размер шрифта – 11, курсив*). Подзаголовки третьего уровня размещаются непосредственно в абзаце (без отступа красной строки).

1. Название раздела 2

Списки (маркированные и нумерованные) оформляются следующим образом:

* Отступ слева – 0,63 см.
* Маркер - точка.
* Выравнивание текста – 1,2 см.
1. Название раздела 3

Все рисунки должны иметь подпись. Для того, чтобы закрепить положение рисунков на листе – помещайте их вместе с названием в таблицы (см. пример ниже). Границы таблицы представлены в примере для наглядности (их стоит сделать невидимыми).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (a) | (b) | (с) |
| **Figure 1.** Название рисунка. Каждая из частей рисунка должна быть пояснена: (а) - …; (b) - … и так далее. |

Далее представлены инструкции по выравниванию рисунков (и подписи к ним на странице).

|  |
| --- |
| WiderFigureShortCaption |
| **Figure 2.** Широкий рисунок, узкая подпись. |
| NarrowFigeWideCap | **Figure 3.** Таким образом подпись стоит размещать в том случае, если объём текстовой части существенно превосходит по занимаемому пространству сам рисунок. |

|  |
| --- |
| WiderFigureWiderCaption |
| **Figure 4.** Широкий рисунок, описание к рисунку не помещается в одной строке. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NarrowFigeWideCap |  | NarrowFigeWideCap |
| **Figure 5.** Два рисунка небольшого размера с подписями. |  | **Figure 6.** Два рисунка небольшого размера с подписями. |

Текстовые подписи на рисунках должны соответствовать по размеру основному шрифту текста (если это возможно). Все линии на рисунках должны быть не тоньше 0,25 ед. Использование цветных иллюстраций приветствуется.

Размещайте рисунки и таблицы таким образом, чтобы обеспечить максимальное заполнение листа.

Далее представлены примеры таблиц с подписями.

|  |
| --- |
| **Table 2.** Малая таблица с длинным текстовым пояснением. В пояснении могут быть интерпретированы представленные в таблице результаты. |
|  |  |
| Distance (m) | Velocity (ms–1) |
| 100 | 23.56 |
| 150 | 34.64 |
| 200 | 23.76 |
| 250 | 27.9 |

**Table 4.** Название более крупной таблицы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wake Chi Sqr. (*N*=15, *df*=1) | *p* | Stage 1 Chi Sqr. (*N*=15, *df*=1) | *p* | Stage 2 Chi Sqr. (*N*=15, *df*=1) | *p* |
| **F3** | 1.143 | 0.285 | 0.286 | 0.593 | 0.286 | 0.593 |
| **Fz** | 1.143 | 0.285 | 0.067 | 0.796 | 0.067 | 0.796 |
| **C4** | 2.571 | 0.109 | 0.600 | 0.439 | 1.667 | 0.197 |

|  |
| --- |
| **Table 4.** Крупная таблица с длинным текстовым пояснением. В пояснении могут быть интерпретированы представленные в таблице результаты.. |
|  | Wake Chi Sqr. (*N*=15, *df*=1) | *p* | Stage 1 Chi Sqr. (*N*=15, *df*=1) | p | Stage 2 Chi Sqr. (*N*=15, *df*=1) | *p* |
| **F3** | 1.143 | 0.285 | 0.286 | 0.593 | 0.286 | 0.593 |
| **Fz** | 1.143 | 0.285 | 0.067 | 0.796 | 0.067 | 0.796 |
| **Cz** | 1.143 | 0.285 | 0.077 | 0.782 | 0.286 | 0.593 |

|  |
| --- |
| **Table 5.** Таблица содержащая сноскиa. |
| Nucleus | Thickness(mg cm–2) | Composition | Separation energies |
| P, n (MeV) | F, 2n (MeV) |
| 181Ta | 19.3±0.1b | Natural | 7.6 | 14.2 |
| 208Pb | 3.8±0.8c | 99% enriched | 7.4 | 14.1 |
| 209Bi | 2.6±0.01c | Natural | 7.5 | 14.4 |
| a Для сносок используйте буквы латинского алфавита (строчные).b Текст сноски.c Текст сноски. |

Ссылки на все рисунки и таблицы должны быть в тексте.

1. Название раздела 4

При наборе формул используйте специальные редакторы: Math Type или MS Equation. Шрифт – соответствующий шрифту основного текста. Формулы выполняются курсивом, векторы выделяются также жирным. При оформлении формул учитывайте следующее:

* вместо 
*  вместо 

Нумеруются только те формулы, на которые Вы ссылаетесь в тексте. Формулы выравниваются по центру листа, в то время как их номера – по правому краю:

  (1)

  (2)

**Acknowledgments**

Последний перед списком источников раздел, в котором Вы можете выразить благодарность коллегам или отметить факт, что работа выполнена при финансовой поддержке грантодателя.

**References**

В соответствии с общими рекомендациями, в ссылках на источники должна быть представлена следующая информация:

* фамилии и инициалы авторов;
* дата публикации;
* название источника (книги, журнала, сборника);
* название статьи (для книги – не указывается);
* номер тома и выпуска (для журналов и периодики);
* редакторы (для сборника или книги);
* для книг и сборников указываются издательство и место (город публикации);
* номера страниц (для книги – не указывается).

Примеры оформления ссылок в списке литературы:

- Статья

Фамилия\_1 И О, Фамилия\_2 И О Год выпускаНазвание статьи *Название журнала наклонным шрифтом* **Номер тома (выпуска) жирным шрифтом** страницы (диапазон или начало)

Semchinova O, Stemmer J and Graul J 2001 Article title *J. Cryst. Growth* **222** 701

- Книга

Фамилия\_1 И О, Фамилия\_2 И О Год выпуска *Название книги наклонным шрифтом* (Город: Издательство)

Sze S M 1969 *Physics of Semiconductor Devices* (New York: Wiley–Interscience)

- труды конференции

Фамилия\_1 И О, Фамилия\_2 И О Год выпуска Название *статьи Название сборника трудов наклонным шрифтом* (Том сборника если есть) ed. редактор сборника (Город и издательство) выпуск страницы

Kuhn T 1998 Density matrix theory of coherent ultrafast dynamics *Theory of Transport Properties of Semiconductor Nanostructures* (Electronic Materials vol 4) ed E Schöll (London: Chapman and Hall) chapter 6 pp 173–214

Источники размещаются в списке в порядке упоминания в тексте. Между номером источника и непосредственно информацией помещается 5 мм отступ (см. пример).

[1] Sze S M 1969 *Physics of Semiconductor Devices* (New York: Wiley–Interscience)

[2] Dorman L I 1975 *Variations of Galactic Cosmic Rays* (Moscow: Moscow State University Press) p 103

[3] Caplar R and Kulisic P 1973 *Proc. Int. Conf. on Nuclear Physics (Munich)* vol 1 (Amsterdam: North-Holland/American Elsevier) p 517

[4] Szytula A and Leciejewicz J 1989 *Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths* vol 12, ed K A Gschneidner Jr and L Erwin (Amsterdam: Elsevier) p 133

[5] Kuhn T 1998 Density matrix theory of coherent ultrafast dynamics *Theory of Transport Properties of Semiconductor Nanostructures* *(Electronic Materials* vol 4*)* ed E Schöll (London: Chapman and Hall) chapter 6 pp 173–214